

2SK776



20S2A

NチャネルMOS形
シリコン電界効果トランジスタ

超高速スイッチング用

©2560

特長 ・低オン抵抗, 超高速スイッチング。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/Ta=25°C

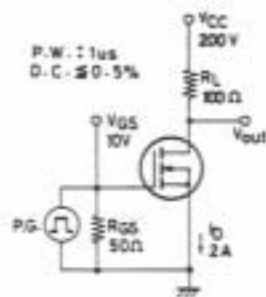
			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DS}	450	V
ゲート・ソース電圧	V _{GS}	±20	V
ドレイン電流(D.C.)	I _D	5	A
ドレイン電流(Pulse)	I _{D peak}	10	A
許容損失	P _D	60	W
接合部温度	T _J	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

T_c=25°C

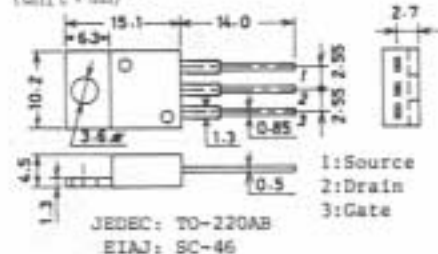
電気的特性 Electrical Characteristics/Ta=25°C

			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V _{DS}	I _D =1mA, V _{GS} =0	450			V
ドレイン・ソースしゅ断電流	I _{DSS}	V _{DS} =450V, V _{GS} =0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0			±100	nA
ゲート・ソースしゅ断電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} =10V, I _D =1mA	1.5		4.0	V
順伝達遅延時間	t _{YFS1}	V _{DS} =10V, I _D =2A	1.2	2.5		s
飽和抵抗	R _{DS(on)}	I _D =2A, V _{GS} =10V		1.2	1.6	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		800		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		100		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} =20V, f=1MHz		20		pF
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	I _D =2A, V _{GS} =10V V _{CC} =200V, R _{GS} =50Ω		20	40	ns
立ち上がり時間	t _r			20	40	ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}			100	200	ns
下降時間	t _f			50	100	ns

スイッチングタイム測定回路



外形図 20S2A
(unit: mm)



注: ゲート・ソース間には保護ダイオードは入っていないため 取扱いに十分注意すること。